

**8 - Mbit的数据闪存（带额外的256千位），最小1.65V
SPI串行闪存**

初步数据表

特点

单1.65V - 3.6V电源
串行外设接口（SPI）兼容
支持SPI模式0和3
支持急流™ 手术
通过整个阵列连续读取功能
高达85MHz的
低功耗读取选项高达15MHz的
时钟到输出时间（ t_{CO} ）为6ns最大
用户可配置的页面大小
每页256字节
每页264字节（默认）
页面大小可以在工厂预先配置为256个字节
两个完全独立的SRAM数据缓冲区（264分之256字节）
允许接收数据而重新编程所述主存储器阵列
灵活的编程选项
字节/页编程（1二百六十四分之二百五十六字节）直接到主存储器
缓冲区写
缓冲区到主存储器页编程

灵活的擦除选项

页擦除（264分之256字节）
块擦除（2KB）
扇区擦除（64KB）
芯片擦除（8兆位）

编程和擦除暂停/恢复

先进的硬件和软件数据保护功能

个别行业的保护
单个扇区锁定作任何扇区永久只读

128字节的一次性可编程（OTP）安全注册

64字节的工厂与一个唯一的标识符编程
64个字节的用户可编程

硬件和软件控制的复位选项

JEDEC标准制造商和设备ID读

低功耗

400nA超深度掉电电流（典型值）
4.5μA深度掉电电流（典型值）
25μA待机电流（典型值）
11毫安有效的读电流（典型值在20MHz）

耐力：每页最低100,000编程/擦除周期

数据保存时间：20年

符合工业温度范围内

绿色（无铅/无卤化物/RoHS标准）的包装选项

8引脚SOIC（0.150"宽0.208"宽）
8垫超薄DFN（5×6×0.6毫米）

描述

该AT45DB081E是一个1.65V的最小，串行接口顺序访问闪存存储器非常适合于各种的数字语音，图像，程序代码和数据存储应用。该AT45DB081E还支持串行急流接口用于要求非常高的速度运行的应用程序。其8650752位存储器组织为4096页256字节或每264个字节。除了在主存储器中，AT45DB081E还包含两个SRAM缓冲器264分之256每个字节。该缓冲器允许接收数据，而在主存储器中的页面进行重新编程。两个缓冲器之间的交织可显著提高系统的写入一个连续的数据流的能力。在

此外，该SRAM缓冲器可以用作额外的系统高速暂存存储器，和（变异性）可与一个自包含三个步骤的读 - 修改 - 写操作处理容易。

²PROM仿真（位或字节

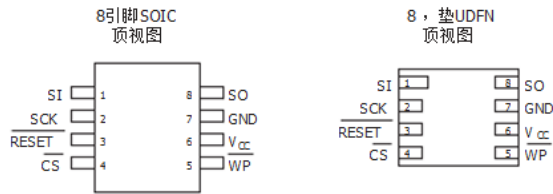
不同于与多个地址线和并行接口，所述随机访问的常规快闪存储器数据闪存[®]采用串行接口，以顺序地存取其数据。简单的顺序访问极大地降低了活跃引脚数，有利于简化硬件设计，提高了系统可靠性，最大限度地降低开关噪声，并减小封装尺寸。该装置被用在许多商业和工业应用中的优化高密度，低引脚数，低电压和低功耗是必不可少的。

以允许简单的在系统重新编程，该AT45DB081E不要求高输入电压为编程。该装置由一个单一的1.65V至3.6V电源为擦除和编程和读操作操作。该AT45DB081E通过片选引脚（CS）启用，并通过3线接口，包括访问的串行输入（SI），串行输出（SO）和串行时钟（SCK）。

所有的编程和擦除周期都是自定时的。

1. 引脚配置和引脚

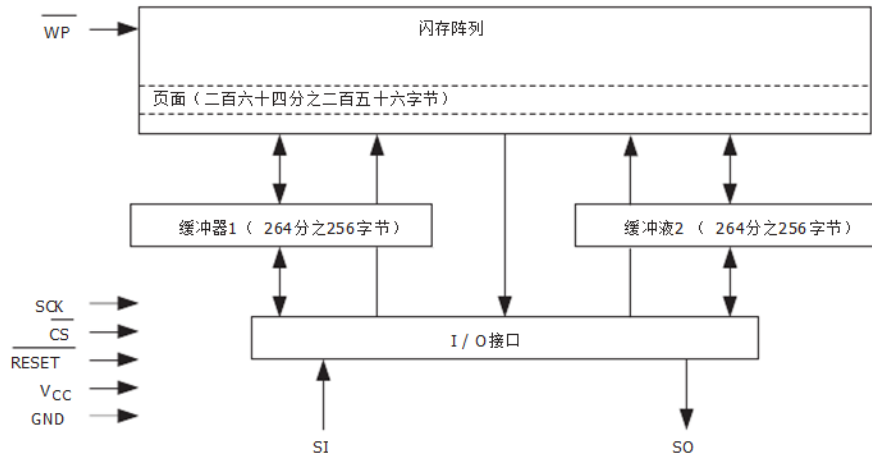
图1-1。插脚引线



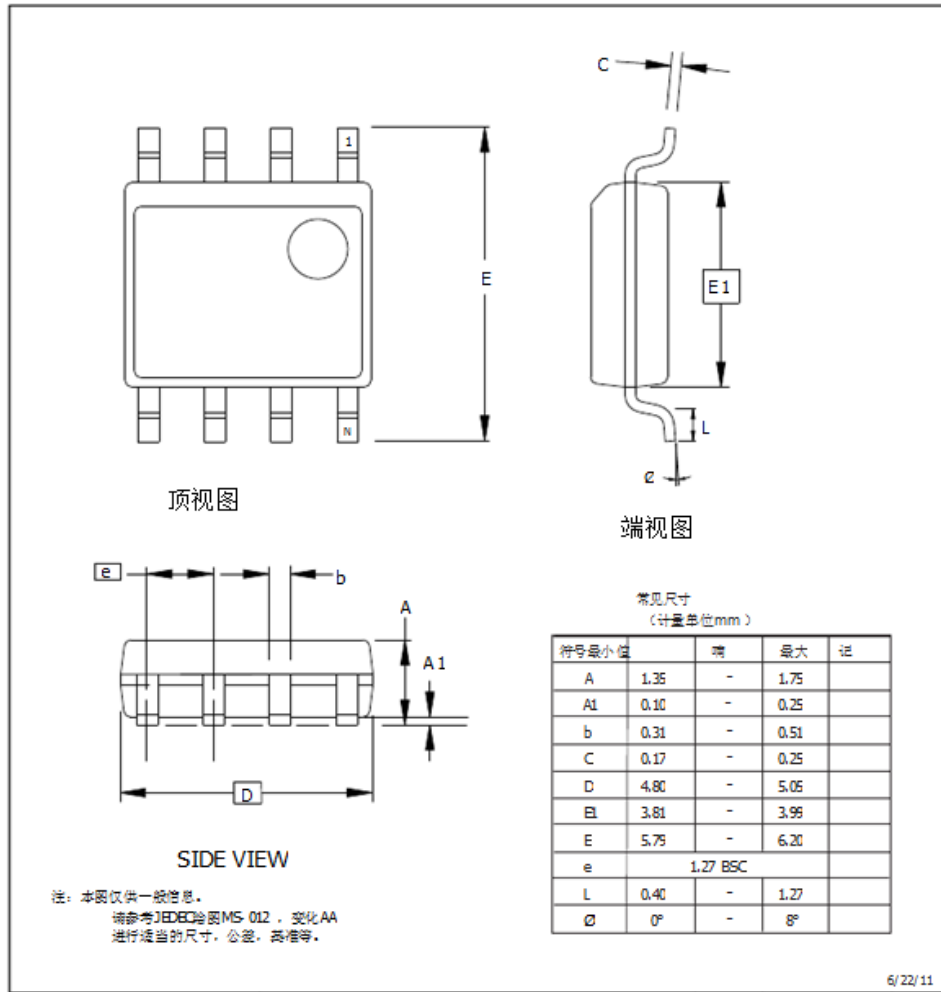
注意：1. 在UDFN封装底部的金属垫内部没有连接到电压电势。这种垫可以是“无连接”，或连接到GND。

2. 框图

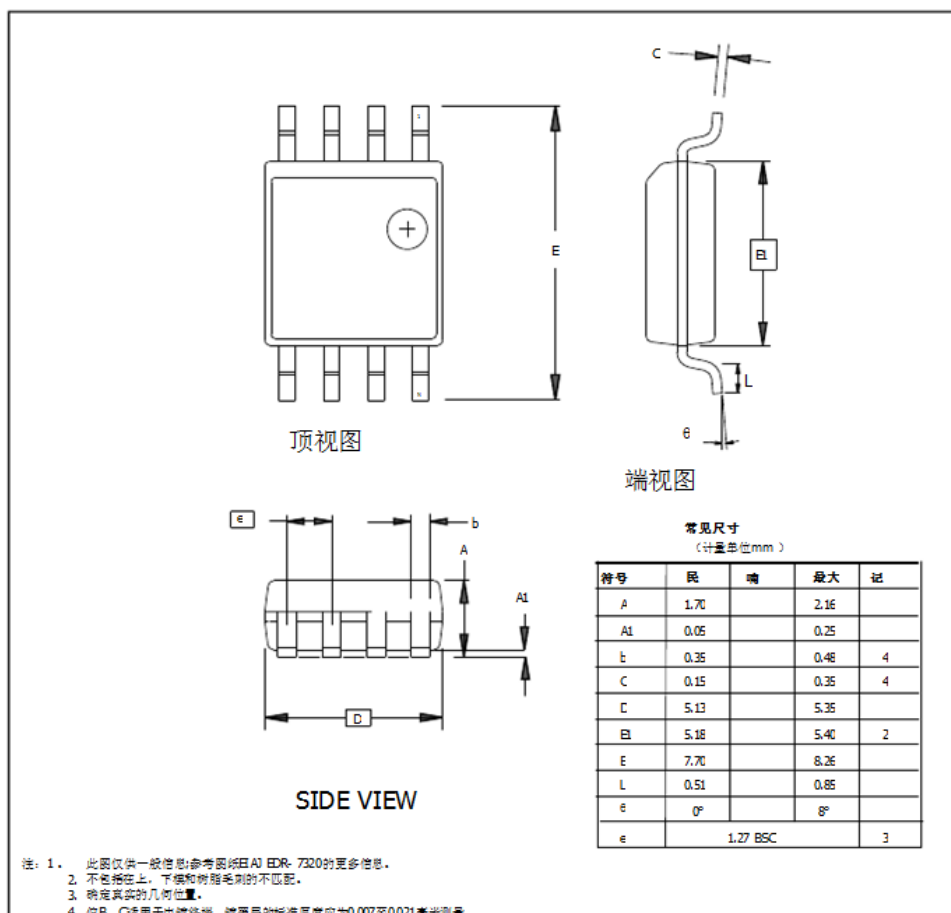
图2-1。框图



28.1 8S1 - 8引脚SOIC封装JEDEC



28.2 8S2 - 8引脚SOIC EIAJ



28.3 8MA1 - 8 - 垫UDFN

